

PNP型 低频放大 小功率 贴片三极管 PNP Plastic-Encapsulate Transistors SMD	HS8550, HS8550A HM8550, HMBT8550 HSS8550, HMA6801 对应其他工业型号 S8550, SS8550 MMBT8550LT1
<ul style="list-style-type: none"> ■ High breakdown voltage ■ Low collector-emitter saturation voltage ■ Complementary to HMBT8050 ■ Transistor Polarity: PNP ■ Transistor pinout: BEC ■ SOT-23 Package ■ Marking Code: 2TY 	

Inner circuit  SOT-23 内部结构	8550 Series  SOT-23 管脚排列 1. Base 2. Emitter 3. Collector	元件标识 (打印)  DEVICE MARKING
---	--	--

DEVICE MARKING 元件标识 (打印)				CLASSIFICATION OF hFE			
型号	MARKING	型号	MARKING	Rank	L	H	J
S8550	2TY	M8550	Y2.	Range	120~200	200~350	300~400
S8550A	2TY.	SS8550	Y.2	细分 hFE RANGE 放大倍数分档	(85~150), (120~220) (200~300), (280~400)		
MA6801	6801	MMBT8550	Y2				

■ MAXIMUM RATINGS 最大额定值

Characteristic 特性参数		Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压	HS8550	V_{CEO}	-25	V
	HMA6801		-18	
Collector-Base Voltage 集电极-基极电压	HS8550	V_{CBO}	-40	
	HMA6801		-25	
Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压		V_{EBO}	-5.0	
Collector Current -Continuous 集电极电流-连续	HS8550, HS8550A	I_C	-500	mA
	HM8550		-1000	
	HMBT8550		-1200	
	HSS8550		-1500	
	HMA6801		-1800	
Total Device Dissipation 耗散功率		P_D	225	mW
Junction Temperature 结温		T_j	150	°C
Storage Temperature Range 储存温度		T_{stg}	-55~+150	

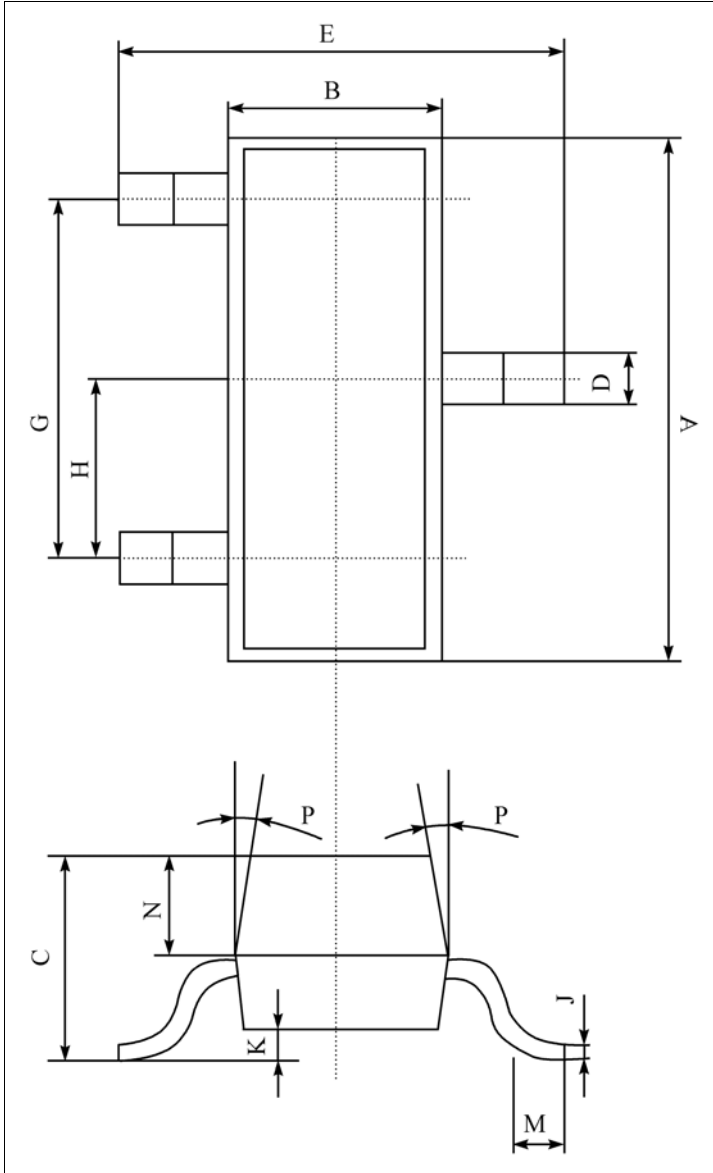


■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

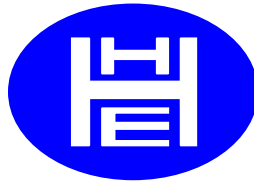
Characteristic 特性参数	Test Condition 测试条件		Symbol 符号	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector Cutoff Current 集电极截止电流	$V_{CB}=-30\text{V}, I_E=0$		I_{CBO}	--	--	-0.1	μA
Emitter Cutoff Current 发射极截止电流	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$		I_{EBO}	--	--	-0.1	
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压	$I_E=0$ $I_C=-100\mu\text{A}$	HS8550	$V_{(BR)CBO}$	-40	--	--	V
		HMA6801		-25	--	--	
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压	$I_E=0$ $I_C=-10\text{mA}$	HS8550	$V_{(BR)CEO}$	-25	--	--	
		HMA6801		-18	--	--	
Emitter Cutoff Current 发射极-基极击穿电压	$I_C=0, I_E=-100\mu\text{A}$		$V_{(BR)EBO}$	-5	--	--	
DC Current Gain 直流电流增益	$I_C=-100\text{mA}, V_{CE}=-1\text{V}$		$h_{FE}(1)$	85	--	400	
DC Current Gain 直流电流增益	$I_C=-500\text{mA}$	HS8550	$h_{FE}(2)$	40	--	--	
		HS8550A		30	--	--	
	$I_C=-800\text{mA}$	HM8550		40	--	--	
		HMBT8550		40	--	--	
		HSS8550		40	--	--	
	$I_C=-1800\text{mA}$	HMA6801		50	--	--	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降	$I_C=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}$		$V_{CE(sat)}$	--	--	-0.6	V
Base-Emitter Voltage 基极-发射极电压	$V_{CE}=-1\text{V}, I_C=-10\text{mA}$		$V_{CE(sat)}$	--	-0.8	-1.0	
Current-Gain-Bandwidth Product 电流增益-带宽乘积	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-10\text{mA}$		f_T	100	120	--	MHz
Collector Output Capacitance 输出电容	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$		C_{ob}	--	13	30	pF

■ DIMENSION 外形封装尺寸数据 (Package: SOT-23 HAOHAI Package Code: MM)

单位 (UNIT) : mm



序号	数值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.20
N	0.60±0.10
P	7±2°
<p>Packing SOT-23 包装规格 SMD片式表面贴封装 包装方式: 载带卷盘包装 Tape & Reel, 3Kpcs/Reel 每卷数量3000只 (3Kpcs/Reel) 每盒数量30000只 (30Kpcs/BOX) 每箱数量300000只 (300Kpcs/Cartons)</p>	



经中华人民共和国工商行政管理总局商标局批准
HAOHAI、HHE 图案、字母、均为我公司正式注册商标，仿冒、盗用均属侵权，违法必究！

深圳市浩海电子有限公司

SHENZHEN HAOHAI ELECTRONICS CO., LTD.

2 floor(whole floor), BAOXIN Building. 0 Lane on the 8th. Yufeng Garden.
82 District. BAOAN District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

中国 广东省 深圳市 宝安区 82区 裕丰花园 零巷8号 宝馨楼 二楼 (全层)

公司电话 TEL: +86-755-29955080、29955081、29955082、29955083
总机八线 29955090、29955091、29955092、29955093

FAX: +86-755-27801767

E-mail: kkg@kkg.com.cn

产品主页 <http://www.szhhe.com>

<http://www.kkg.com.cn>